

KOMPONEN KERTAS ELEKTRIK

**PEMBUATAN SEL SURYA STRUKTUR MS Cr/Si-P
DENGAN TEKNIK EVAPORASI**

SKRIPSI



KKS
KK

MP.F. 396/94

Ine
p

Oleh :

NI KETUT INDIRAYATI

NIM. 088930713

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1993

PEMBUATAN SEL SURYA STRUKTUR MS Cr/Si-P
DENGAN TEKNIK EVAPORASI

SKRIPSI

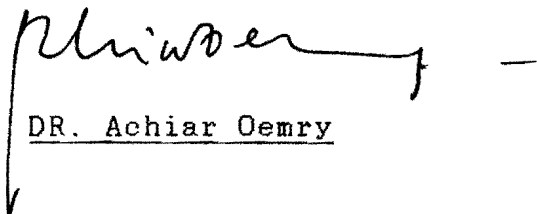
OLEH :

NI KETUT INDIRAYATI

NIM. 088930713

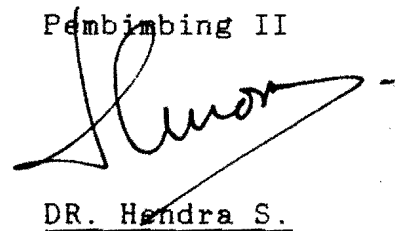
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



DR. Achiar Oemry

Pembimbing II



DR. Hendra S.

A B S T R A K

Telah dibuat sel surya Cr dengan melapiskan chromium pada kristal tunggal silikon tipe-p dengan dua sampel yang berbeda. Pelapisan dilakukan dengan metode evaporasi termal.

Dari pengukuran karakteristik $I - V$ untuk sampel 1 diperoleh hasil arus bocor pada suhu kamar $I_g = (5,4 \times 10^{-6} \pm 2,3 \times 10^{-6})$ A, arus sirkuit tertutup $I_{sc} = (2,8 \pm 0,1)$ mA, tegangan sirkuit terbuka $(84 \pm 0,1)$ mV, efisiensi $\eta = (1,2 \pm 0,08)$ %, Fill Factor (FF) = $(0,32 \pm 0,04)$ dan harga respon spektral (SR) pada panjang gelombang 6328 Å = 0,03 dengan luas sel surya yang disinari $0,0625 \text{ cm}^2$.